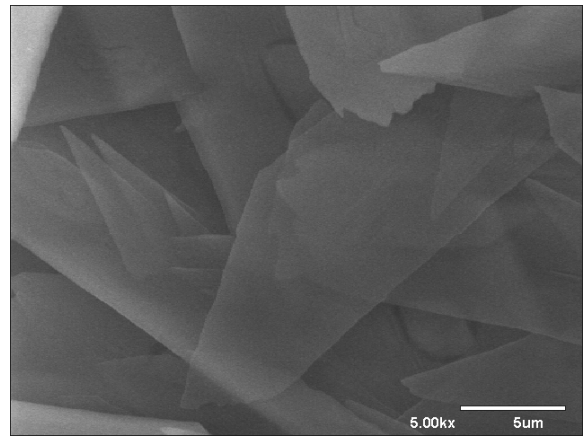
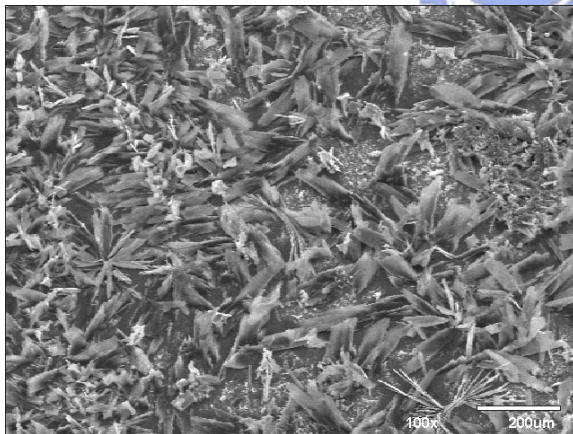


(a)

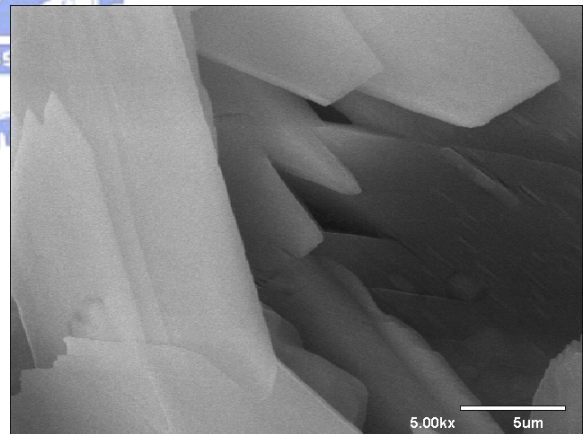


(b)

圖4-7 以 $2\text{mA}/\text{cm}^2$ 電流密度、電解液 25°C 之沉積條件並經由 300°C 燒結之單層HAp鍍層SEM照片。



(a)

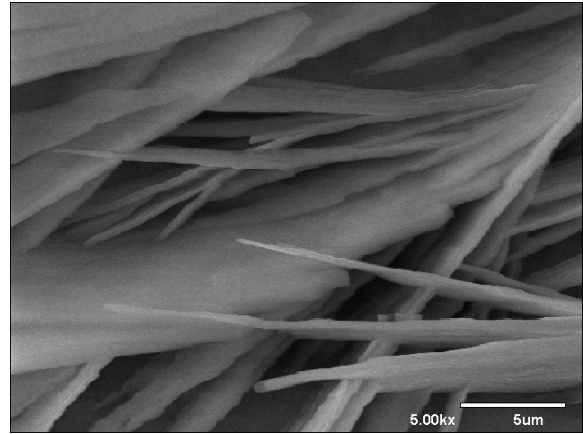


(b)

圖4-8 以 $3\text{mA}/\text{cm}^2$ 電流密度、電解液 25°C 之沉積條件並經由 300°C 燒結之單層HAp鍍層SEM照片。

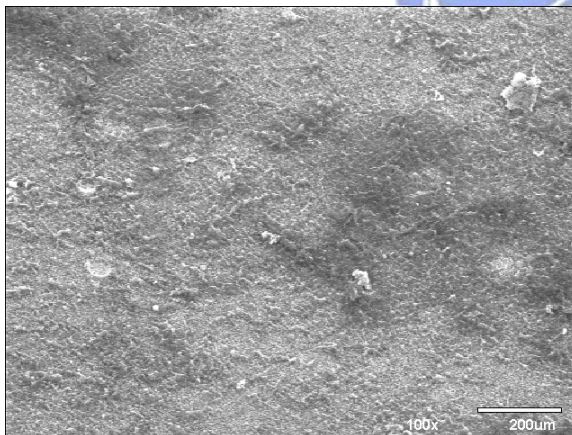


(a)

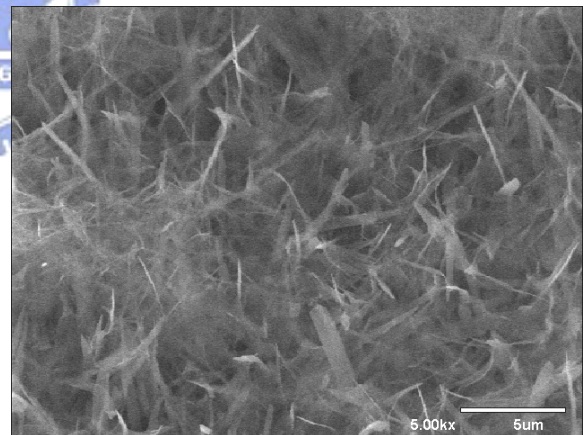


(b)

圖4-9 以 $4\text{mA}/\text{cm}^2$ 電流密度、電解液 25°C 之沉積條件並經由 300°C 燒結之單層HAp鍍層SEM照片。

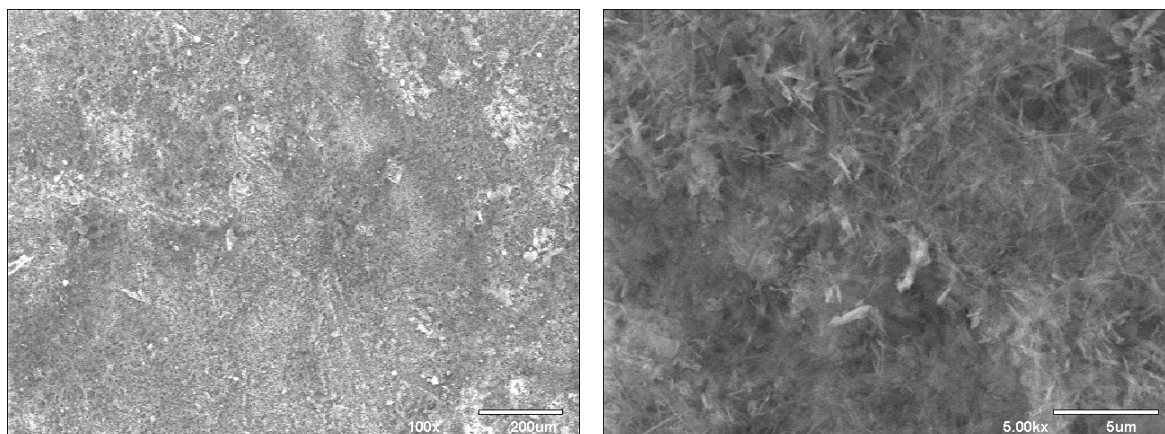


(a)



(b)

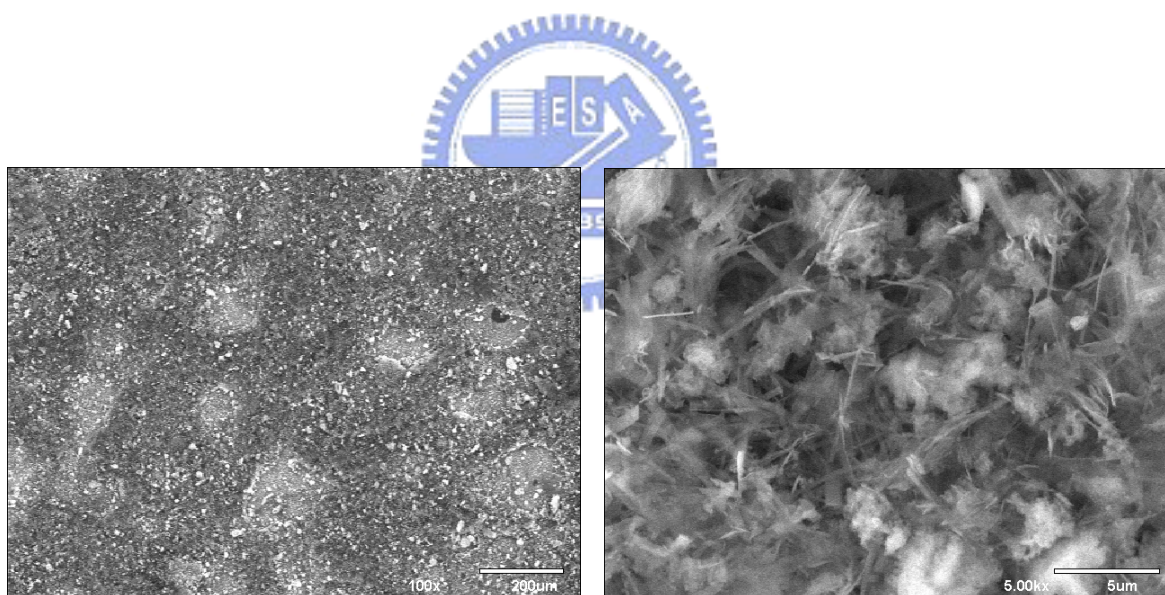
圖4-10 以 $2\text{mA}/\text{cm}^2$ 電流密度、電解液 65°C 之沉積條件並經由 300°C 燒結之單層HAp鍍層SEM照片。



(a)

(b)

圖4-11 以 $3\text{mA}/\text{cm}^2$ 電流密度、電解液 65°C 之沉積條件並經由 300°C 燒結之單層HAp鍍層SEM照片。



(a)

(b)

圖4-12 以 $4\text{mA}/\text{cm}^2$ 電流密度、電解液 25°C 之沉積條件並經由 300°C 燒結之單層HAp鍍層SEM照片。